

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成21年7月30日(2009.7.30)

【公開番号】特開2007-43118(P2007-43118A)

【公開日】平成19年2月15日(2007.2.15)

【年通号数】公開・登録公報2007-006

【出願番号】特願2006-179052(P2006-179052)

【国際特許分類】

H 05 K 3/20 (2006.01)

H 05 K 3/28 (2006.01)

H 01 L 21/336 (2006.01)

H 01 L 29/786 (2006.01)

H 01 L 21/3205 (2006.01)

【F I】

H 05 K 3/20 B

H 05 K 3/28 F

H 01 L 29/78 6 2 7 D

H 01 L 21/88 B

【手続補正書】

【提出日】平成21年6月12日(2009.6.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板上に設けられた導電性を示すパターン上に、電解めっき処理により導電膜を形成し

、前記導電膜に基体を貼り付け、

前記基体を前記基板から剥がすことにより、前記パターンと前記導電膜とを分離することを特徴とする配線基板の作製方法。

【請求項2】

基板上に設けられた導電性を示すパターン上に、電解めっき処理により導電膜を形成し

、前記電解めっき処理の後、前記基板を洗浄し、

前記導電膜に基体を貼り付け、

前記基体を前記基板から剥がすことにより、前記パターンと前記導電膜とを分離することを特徴とする配線基板の作製方法。

【請求項3】

請求項1又は請求項2において、

前記パターンは、Fe、Al、Cu、Ag、Ni、W、Ti、Mg、Nb、又はSnを含むことを特徴とする配線基板の作製方法。

【請求項4】

請求項1乃至請求項3のいずれか一項において、

前記導電膜は、AgとAuとの合金、CuとAuとの合金、NiとAuとの合金、CdとAuとの合金、CoとAuとの合金、Cu、Ni、Sn、Pb、Cr、Au、Ag、Rh、Co、又はCdを含むことを特徴とする配線基板の作製方法。

【請求項 5】

第1の基板上に設けられた導電性を示すパターン上に、電解めっき処理により導電膜を形成し、

前記導電膜に基体を貼り付け、

前記基体を前記基板から剥がすことにより、前記パターンと前記導電膜とを分離し、

前記導電膜と、第2の基板上に設けられ少なくとも1つの薄膜トランジスタを有するICチップとを、電気的に接続することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 6】

第1の基板上に設けられた導電性を示すパターン上に、電解めっき処理により導電膜を形成し、

前記導電膜に基体を貼り付け、

前記基体を前記基板から剥がすことにより、前記パターンと前記導電膜とを分離し、

第2の基板上に設けられ少なくとも1つの薄膜トランジスタを有するICチップ上に、導電性樹脂を形成し、

前記導電性樹脂を介して、前記導電膜と前記ICチップとを電気的に接続することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 7】

第1の基板上に設けられた導電性を示すパターン上に、電解めっき処理により導電膜を形成し、

前記導電膜に基体を貼り付け、

前記基体を前記基板から剥がすことにより、前記パターンと前記導電膜とを分離し、

前記導電膜と、第2の基板上に設けられ少なくとも1つの薄膜トランジスタを有するICチップとを、電気的に接続し、

前記ICチップと前記導電膜とを第3の基板で覆うことを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 8】

請求項7において、

前記第3の基板は、ポリプロピレン、ポリエステル、ビニル、ポリフッ化ビニル、塩化ビニル、纖維質な材料からなる紙、又は帯電防止フィルムを含むことを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 9】

請求項7において、

前記第3の基材は、基材フィルムと合成樹脂フィルムとの積層フィルムを含むことを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 10】

請求項9において、

前記基材フィルムは、ポリエステル、ポリアミド、無機蒸着フィルム、又は紙類であることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 11】

請求項9又は請求項10において、

前記合成樹脂フィルムは、アクリル系合成樹脂又はエポキシ系合成樹脂であることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 12】

請求項5乃至請求項11のいずれか一項において、

前記パターンは、Fe、Al、Cu、Ag、Ni、W、Ti、Mg、Nb、又はSnを含むことを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 13】

請求項5乃至請求項12のいずれか一項において、

前記導電膜は、AgとAuとの合金、CuとAuとの合金、NiとAuとの合金、CdとAuとの合金、CoとAuとの合金、Cu、Ni、Sn、Pb、Cr、Au、Ag、R

h、Co、又はCdを含むことを特徴とする半導体装置の作製方法。